2SA839

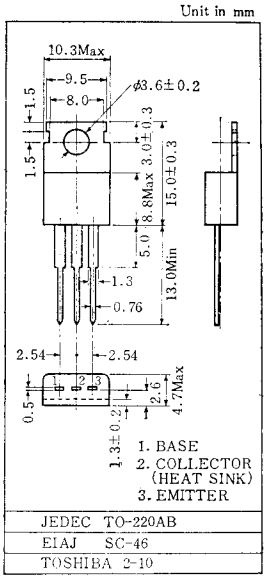
シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

○低周波電力増幅用　○励振段電力増幅用

○ Audio Power Amplifier Applications

○ Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です：$V_{CEO}=-150V$
- 高出力 Hi-Fi Amp. の励振段に適します.
- 2SC1669 とコンプリメンタリになります.
- Complementary to 2SC1669



アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT NO. AC75

最大定格　MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55～150	°C

電気的特性　ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-100V$, $I_E=0$	—	—	−20	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V$, $I_C=0$	—	—	−10	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10mA$, $I_B=0$	−150	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1mA$, $I_C=0$	−5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ Note	$V_{CE}=-10V$, $I_C=-0.5A$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-10V$, $I_C=-1A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA$, $I_B=-50mA$	—	—	−1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-10V$, $I_C=-0.5A$	−0.7	—	−1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10V$, $I_E=0.5A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0$, f=1MHz	—	100	····	pF

Note；$h_{FE(1)}$ により下表のように分類し，現品表示してあります.
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA839 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA839—R	40	80
2SA839—O	70	140
2SA839—Y	120	240